

УДК 548 : 537.611.46

© 1991

## КОЭРЦИТИВНОСТЬ ДОМЕННЫХ ГРАНИЦ В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

B. K. Власко-Власов, O. A. Тихомиров

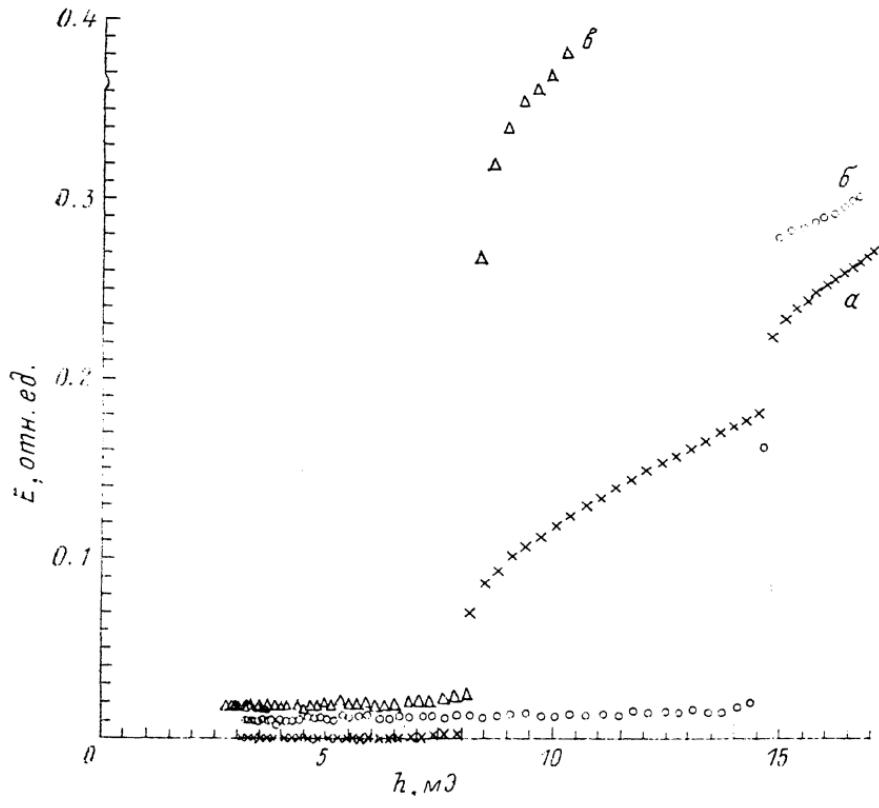
Проведены исследования коэрцитивности в переменном поле отдельных доменных стенок в пластинах иттриевого феррограната. Обнаружена необычная зависимость коэрцитивности от частоты поля. Эта зависимость связывается с кооперативностью динамического отклика доменной структуры, определяемой полями размагничивания внутри кристалла.

Коэрцитивная сила  $h_c$  является одной из важнейших характеристик ферромагнетика. В магнитомягких материалах она определяется в основном взаимодействием доменных границ (ДГ) с дефектами кристаллической структуры. Однако при конечных скоростях перемагничивания появляются различные динамические добавки. Например, при определении коэрцитивности традиционным способом (по петле гистерезиса) измеряемое значение  $h_c$  за счет таких добавок увеличивается при возрастании частоты поля [<sup>1-4</sup>]. Это связано с тем, что при высоких частотах намагченность отстает от внешнего поля вследствие эффектов динамического затухания и ширина петли гистерезиса увеличивается. Другой распространенный способ определения коэрцитивности состоит в аппроксимации к  $V=0$  линейного участка зависимости скорости ДГ  $V$  от высоты ступеньки приложенного поля  $H$  [<sup>5-7</sup>]. В этом случае также имеются различные добавки к  $h_c$ , зависящие от типа доменной структуры и приводящие к несовпадению динамической и статической коэрцитивностей. Поэтому для различных типов доменной структуры (полосовой, лабиринтной, цилиндрических магнитных доменов) в таких экспериментах получаются разные значения  $h_c$  [<sup>7</sup>].

С развитием магнитооптических методов исследования доменной структуры большое распространение получил способ определения коэрцитивности в низкочастотном переменном магнитном поле [<sup>7-10</sup>]. Коэрцитивность  $h_c$  отождествляется с амплитудой поля, при достижении которой начинает регистрироваться сигнал от движущихся стенок. Этот метод дает меньшее по сравнению с другими значение  $h_c$ ; считается, что оно не имеет динамических добавок и характеризует истинную величину взаимодействия ДГ с дефектами [<sup>7</sup>].

В данной работе показано, что даже при достаточно низких частотах коэрцитивность, измеряемая для отдельных стенок в переменном поле, определяется не только силой взаимодействия с центрами пиннинга, но и зависит от частоты поля  $f$ , от движения других ДГ. При повышении частоты  $h_c$  уменьшается в отличие от известной зависимости  $H_c = H_0 + cf^\alpha$  ( $\alpha > 0$ ) для коэрцитивности, определенной из петли гистерезиса [<sup>1-4</sup>]. Такое необычное поведение определяется тем, что при условии небольших различий в силе пиннинга различных ДГ внутреннее эффективное поле, действующее на отдельную стенку, сильно зависит от полей размагничивания, связанных с движением других границ.

Исследования проводились на монокристаллических пластинах [112] иттриевого феррограната размером  $7 \times 1 \times 0.05$  мм с осью легкого намагничивания, лежащей вдоль длинной стороны. Они содержали, как правило, от двух до четырех ДГ, закрепленных вблизи краев кристалла треугольными замыкающими комплексами. Образец помещался в плоскую соленоидальную катушку, создававшую переменное магнитное поле, поляризованное вдоль легкой оси. Колебания доменных стенок изучались посредством фотометрирования магнитооптического сигнала от узкой диафрагмы, помещаемой в поляризационном микроскопе на краю изображения доменной стенки. Одновременно проводилось измерение эдс,



На рис. 2 представлены амплитудные зависимости индукционного сигнала  $E(h)$ , измеренные при нескольких частотах внешнего поля. Различие в наклоне линейных участков вызвано тем, что наводимая эдс пропорциональна частоте поля. Видно, что при этих частотах коэрцитивность одной из стенок (начинающей колебаться в более слабом поле)  $h_{c1}$  практически не изменяется. В то же время значение поля  $h_{c2}$ , при котором начинает колебаться вторая ДГ, существенно зависит от частоты  $f$ . Построенные на основе подобных измерений зависимости  $h_c(f)$  и  $h_{c2}(f)$  приведены на рис. 3. При малых  $f h_{c2}$  значительно превышает  $h_{c1}$  и колеблется только первая стенка. С ростом  $f$  величина  $h_{c2}$  уменьшается, а при частотах порядка 150 кГц кривая  $h_{c2}(f)$  достигает минимального значения. При увеличении частоты выше 300 кГц точность определения  $h_c$  падает из-за уменьшения амплитуды колебаний стенок вследствие ре-

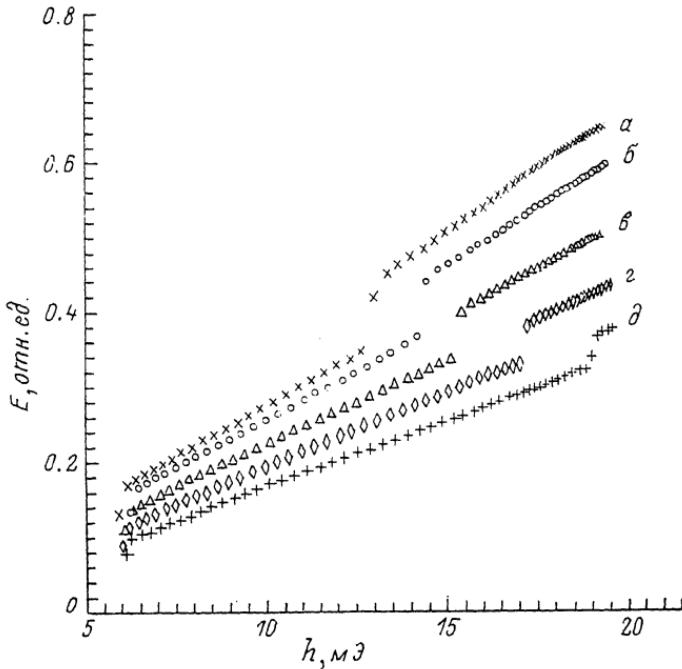


Рис. 2. Зависимость величины индукционного сигнала  $E$  от амплитуды магнитного поля  $h$  при различных частотах поля.

$f$ , кГц:  $a = 50$ ,  $b = 45$ ,  $c = 40$ ,  $\varrho = 35$ ,  $\partial = 30$ .

лаксации. Тем не менее удается выявить увеличение  $h_{c1}$  с частотой. При этом начиная с  $f=200$  кГц значения  $h_{c1}$  и  $h_{c2}$  практически совпадают и на кривых  $E(h)$  остается лишь одна ступенька.

Полученные зависимости коэрцитивности отдельных стенок можно объяснить на основе простой модели. Рассмотрим систему из двух ДГ, связанных между собой магнитостатическим взаимодействием. В отсутствие внешних полей это взаимодействие определяет равновесное расстояние между стенками. При наложении внешнего поля ДГ смещаются и магнитостатическая энергия растет. При этом на каждую стенку действует квазиупругая (при малых смещениях) сила, пропорциональная изменению расстояния между ДГ. Если частота поля достаточно мала, можно пренебречь массой ДГ и записать уравнения их колебаний в виде

$$\beta_1 \dot{z}_1 + k_1 z_1 = 2Mh(t) + A(z_2 - z_1), \quad (4)$$

$$\beta_2 \dot{z}_2 + k_2 z_2 = -2Mh(t) + A(z_2 - z_1), \quad (1)$$

где  $z_j$  — смещение  $j$ -й стенки;  $\beta_j$  — коэффициент затухания;  $k_j$  — коэффициент возвращающей силы, описывающий взаимодействие ДГ с цен-

тром пиннинга;  $A$  — коэффициент магнитостатической возвращающей силы;  $h(t) = h_0 \exp(i\omega t)$  — переменное магнитное поле;  $M$  — намагниченность насыщения. Коэффициент  $k_j$  можно считать постоянным, когда стенка локализована на дефекте, и равным нулю, когда ДГ удалена от него. В зависимости от величины внешнего поля возможны три основных режима колебаний.

Режим 1 (слабое поле). Обе стенки закреплены на дефектах, их смещения малы. В этих условиях можно пренебречь магнитостатическим членом, а величины  $k_j$  считать постоянными и большими по сравнению с  $A$  и  $\omega\beta_j$ . Сохраняя в решении  $z_j = x_j + iy_j$  (где  $x_j$  — совпадающая по фазе с внешним полем,  $y_j$  — сдвинутая на  $\pi/2$  компоненты смещения) только линейные по малому параметру  $k_j^{-1}$  члены, получим  $x_1 = 2Mh_0/k_1$ ,  $x_2 = -2Mh_0/k_2$ ,  $y_j = 0$ .

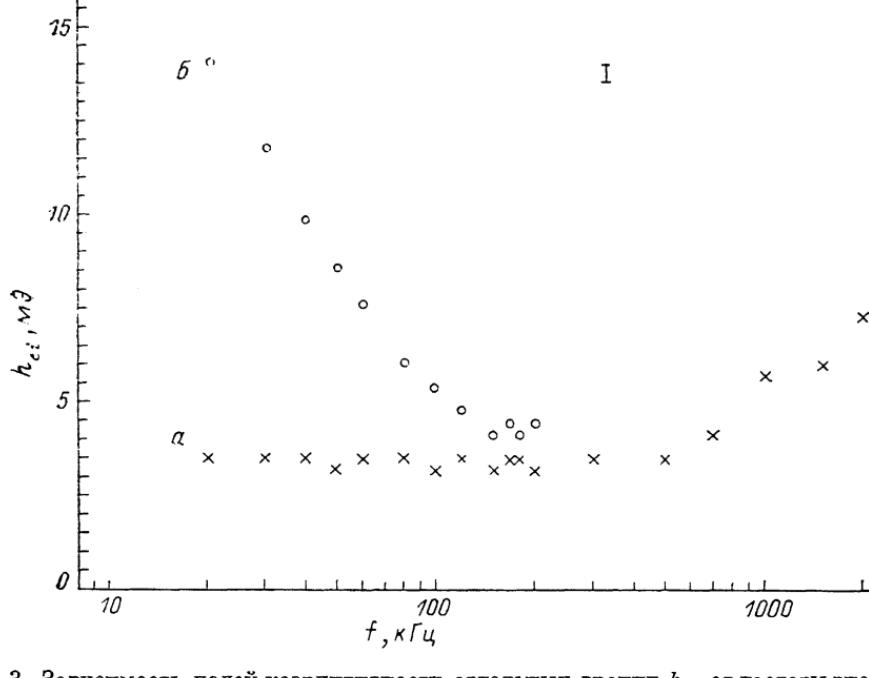


Рис. 3. Зависимость полей коэрцитивности отдельных границ  $h_{cj}$  от частоты внешнего поля  $f$ .  $a$  —  $h_{c1}$ ,  $b$  —  $h_{c2}$ .

Режим 2 (сильное поле). Обе стенки колеблются с большой амплитудой и на протяжении почти всего периода находятся вне потенциальной ямы дефекта. Тогда, пренебрегая влиянием дефекта на больших расстояниях, можно опустить члены с  $k_j$ . Решение полученного уравнения имеет вид

$$\begin{aligned} x_1 &= A(\beta_1 + \beta_2)\beta_2 C, & y_1 &= -\omega\beta_1\beta_2^2 C, \\ x_2 &= -A(\beta_1 + \beta_2)\beta_1 C, & y_2 &= -\omega\beta_1^2\beta_2 C, \\ C &= \frac{2Mh_0}{A^2(\beta_1 + \beta_2)^2 + \omega^2\beta_1^2\beta_2^2}. \end{aligned} \quad (2)$$

Режим 3 (промежуточное поле). Пусть  $k_2 > k_1$ . При этом в некотором интервале амплитуд поля заметно колеблется только первая стенка, а вторая остается закрепленной. Тогда, полагая  $k_1 = 0$  и оставляя в решении лишь линейные по  $k_2^{-1}$  члены, имеем (при  $k_2 \gg \omega\beta_2$ ,  $k_2 \gg A$ )

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2Mh_0 A}{A^2 + \beta_1^2\omega^2}, & y_1 &= -\frac{\omega\beta_1}{A} x_1, \\ x_2 &= -\frac{\omega^2\beta_1^2}{Ak_2} x_1, & y_2 &= -\frac{\omega\beta_1}{k_2} x_1. \end{aligned} \quad (3)$$

Теперь рассмотрим переход от одного режима к другому. Будем считать, что стенка открывается от дефекта и начинает колебаться, когда абсолютная величина действующей на нее силы (состоящей из силы вязкого трения, давления внешнего поля и поля размагничивания) достигает некоторого критического значения  $P$ , характеризующего силу пиннинга ДГ на дефекте. Это условие можно записать в виде

$$2Mh_0 + A(z_2 - z_1) \mp \beta z_j = P_j. \quad (4)$$

Для нахождения величины переменного поля  $h_{c1}$ , при котором начнет колебаться первая стенка, в это уравнение надо подставить  $x_j$  и  $y_j$ , опре-

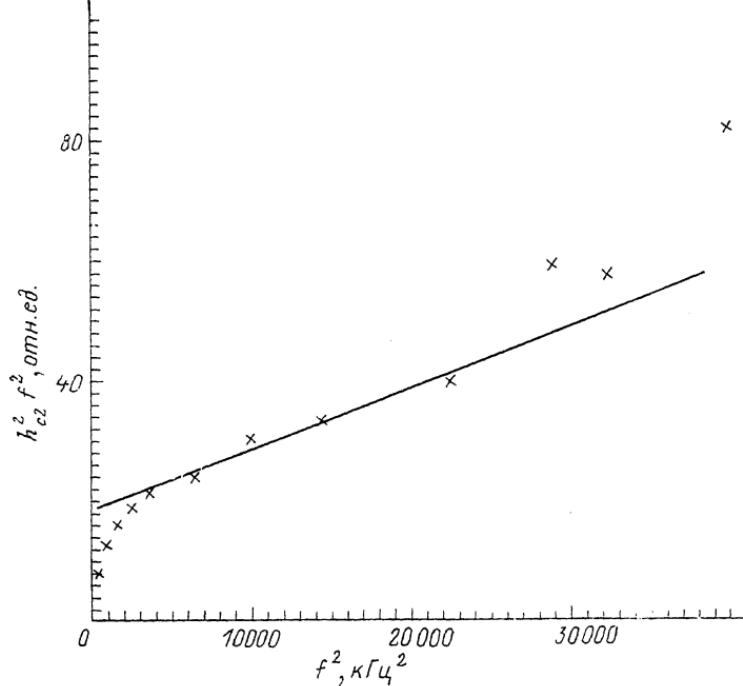


Рис. 4. Сравнение расчетной коэрцитивности второй стенки (сплошная линия) с экспериментальными значениями  $h_{c2}$  (точки).

деленные для режима 1. Отбрасывая малые добавки, содержащие  $k_j^{-1}$ , получим тривиальное соотношение

$$2Mh_{c1} = P_1. \quad (5)$$

Таким образом, в рамках сделанных приближений  $h_{c1}$  равно статической коэрцитивной силе. Проделывая аналогичную процедуру для решений, соответствующих промежуточному режиму 3, получаем  $h_{c2}$

$$2Mh_{c2} = \frac{P_2}{\beta_1 \omega} (A^2 + \beta_1^2 \omega^2)^{1/2}. \quad (6)$$

При малых частотах  $h_{c2}$  обратно пропорционально  $\omega$ , а с ростом частоты стремится к постоянному значению  $P_2/2M$ . Физически это означает, что при медленном изменении поля смещение первой стенки (с меньшей коэрцитивностью) приводит к синхронному с полем изменению поля размагничивания, которое полностью компенсирует внешнее поле. В итоге сила, действующая на вторую стенку, остается равной нулю, пока первая ДГ движется в фазе с полем. При повышении частоты смещение первой ДГ отстает от изменения поля вследствие затухания и разность внешнего и размагничивающего полей воздействует на вторую стенку. Поэтому «истинная» коэрцитивность второй ДГ проявляется только при частотах, превышающих релаксационную.

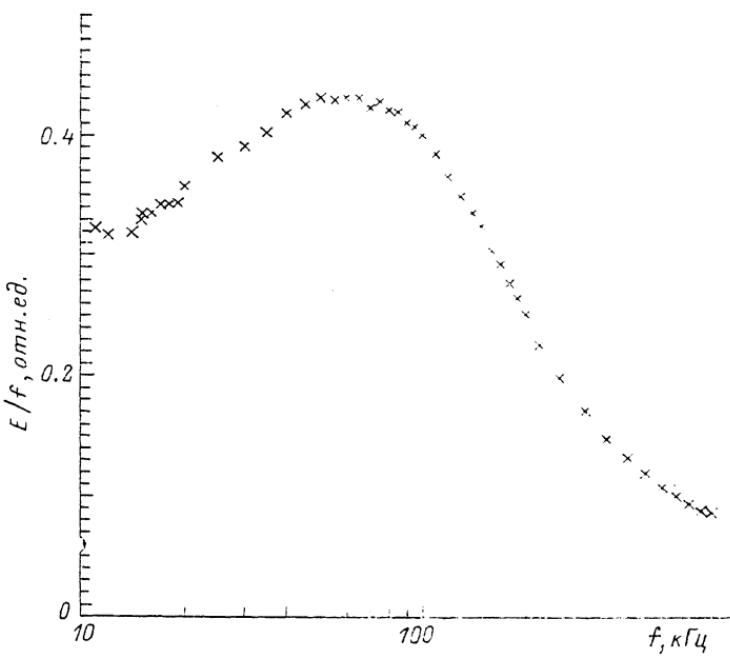


Рис. 5. Зависимость нормированного на частоту индукционного сигнала (пропорционального суммарной амплитуде смещений  $Df$ ) от частоты внешнего поля.

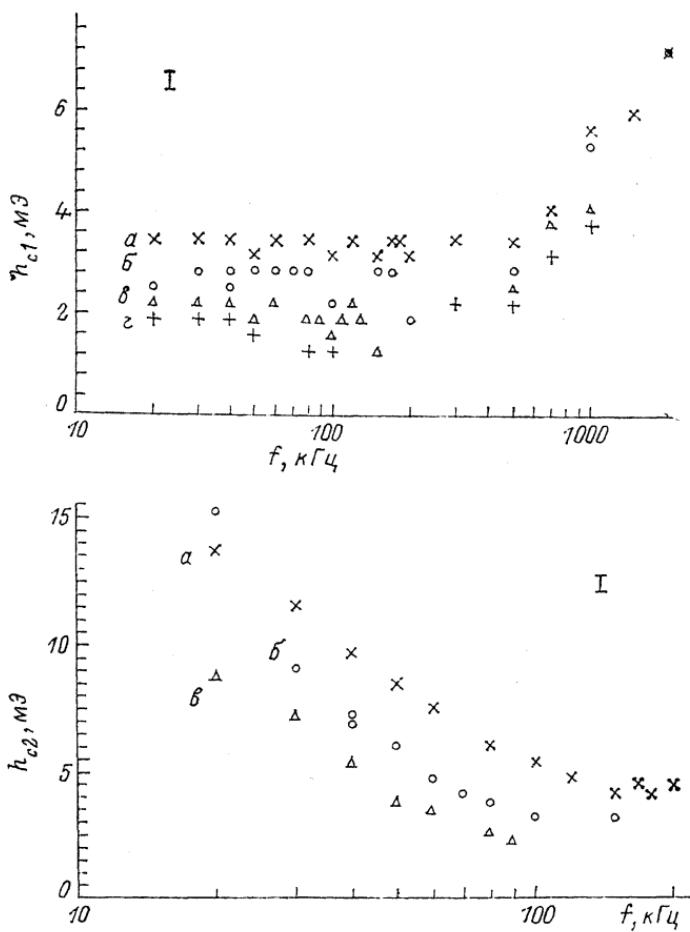


Рис. 6. Зависимость полей коэрцитивности  $h_{cj}$  от частоты поля  $f$  при различных температурах.

Вверху —  $h_{c1}(f)$ , внизу —  $h_{c2}(f)$ .  $a = 298$ ,  $b = 314$ ,  $c = 330$ ,  $d = 372$  К.

Предложенная модель объясняет наблюдаемые в эксперименте убывание  $h_{c2}$  с частотой и постоянное значение  $h_{c1}$  в области низких частот. Однако при самых низких, а также при достаточно высоких  $f$  измеренные значения  $h_{c2}$  заметно отклоняются от частотной зависимости (6). Это иллюстрирует рис. 4, на котором представлена зависимость  $f^2 h_{c2}^2$  от  $f^2$ . Экспериментальная кривая отходит от линейной зависимости (6) при  $f < 50$  кГц и  $f > 150$  кГц. Это несоответствие связано, по-видимому, со сделанными при анализе приближениями. На рис. 5 приведена измеренная при постоянном  $h$  зависимость величины  $E/f$  (пропорциональной сумме смещений ДГ) от частоты поля  $f$ , из которой следует, что спектр колебаний не является релаксационным. Учет массы ДГ мог бы изменить частотную

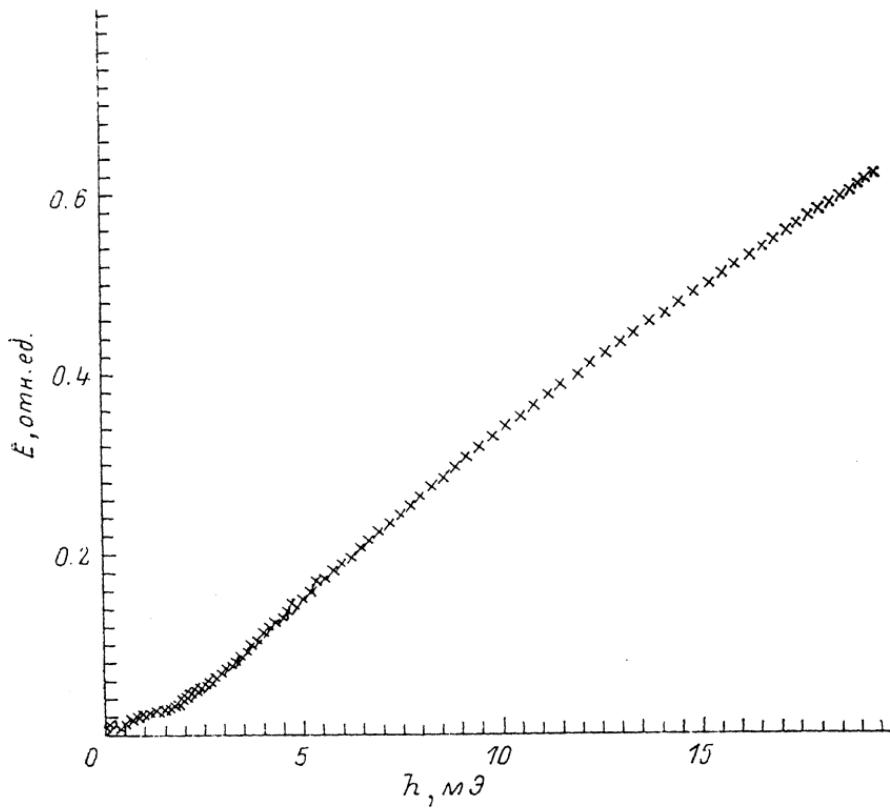


Рис. 7. Зависимость величины индукционного сигнала  $E$  от амплитуды магнитного поля  $h$  при высокой температуре (350 К).  $f=200$  кГц.

зависимость в области высоких частот, однако из анализа следует, что коэрцитивность при этом должна уменьшаться с ростом  $\omega$ . Скорее всего, в данной области частот начинают проявляться опущенные при анализе нелинейные члены (их учет приведет к появлению в правой части выражений (5) и (6) квадратичных по  $\beta, \omega/k$ , добавок). Помимо отклонений частотной зависимости  $h_{c2}$  от (6) эти добавки вызывают зафиксированное в эксперименте возрастание  $h_{c1}$  на высоких частотах.

Уменьшение магнитостатической связи между соседними ДГ должно приводить к ослаблению эффекта. Этого можно достичь повышением температуры образца  $T$ . На рис. 6 приведены зависимости  $h_{c1}$  и  $h_{c2}$  от частоты поля, измеренные для разных  $T$ . Видно, что при повышении температуры  $h_{c2}$  уменьшаются в соответствии с известными температурными зависимостями коэрцитивности (например, [11, 12]). При этом  $h_{c2}$  начинает совпадать с  $h_{c1}$  при более низких частотах. Дальнейший нагрев кристалла приводит к тому, что на зависимости индукционного сигнала  $E$  от амплитуды поля  $h$  остается только одна особенность (рис. 7). Это означает,

что коэрцитивности обеих стенок примерно одинаковы и влияние полей размагничивания на величину  $h_{c2}$  мало.

Таким образом, в данной работе показано, что коэрцитивность отдельных стенок в переменном магнитном поле определяется не только их взаимодействием с дефектами, но и наличием других колеблющихся границ. Воздействие полей размагничивания, возникающих при смещении ДГ, приводит к уменьшению результирующего давления на другие стенки. Это выражается в зависимости коэрцитивности ДГ от частоты внешнего поля.

### Список литературы

- [1] Пак Н. Г., Кан С. В. // Изв. АН СССР, сер. Физ. 1966. Т. 30. № 1. С. 80—82.
- [2] Ondrusz J. // Zesz. nauk. AGH. 1970. V. 249. Р. 3—8.
- [3] Gyorgy E. M., Leamy H. J., Sherwood R. C., Chen H. S. // AIP Conf. Proc. 1976. V. 29. Р. 198—203.
- [4] Дорофеева Е. А., Макаров В. П. // ФММ. 1978. Т. 45. № 1. С. 38—43.
- [5] Patterson R. W. // J. Appl. Phys. 1974. V. 45. N 11. P. 5018—5022.
- [6] Thiele A. A., Asselin P. // J. Appl. Phys. 1984. V. 55. N 6 11B. P. 2584—2586.
- [7] Vertesy G., Pardavi-Horvath M., Bodis I., Pinter I. // J. Magn. Magn. Mater. 1988. V. 75. N 3. P. 389—396.
- [8] Josephs R. M. // AIP Conf. Proc. 1973. V. 10. Pt. 1. Р. 286—303.
- [9] Бажажин Г. А., Ильичева Е. Н., Котов В. А., Телеснин Р. В., Шишков А. Г. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 1. С. 257—260.
- [10] Gaunt P., Ng D. // IEEE Trans. Magn. 1989. V. 25. N 5. С. 3857—3859.
- [11] Pardavi-Horvath M., Vertesy G. // J. Appl. Phys. 1985. V. 58. N 10. P. 3827—3833.
- [12] Gaunt P. // Canad. J. Phys. 1987. V. 65. N 10. P. 1194—1199.

Институт физики твердого тела  
РАН

Черноголовка  
Московская обл.

Поступило в Редакцию  
12 июля 1991 г.